PAT-NO:

JP403069119A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03069119 A

TITLE:

BATCH DRY ETCHING APPARATUS

PUBN-DATE:

March 25, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAKAO, YASUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC YAMAGUCHI LTD

N/A

APPL-NO: JP01206213

APPL-DATE: August 8, 1989

INT-CL (IPC): H01L021/302

ABSTRACT:

PURPOSE: To enhance the uniformity of etching rate between wafers and inside one wafer by a method wherein a lower-part electrode is turned around its central axis and stages are rotated and revolved.

CONSTITUTION: In a batch-system dry etching apparatus, wafers are arranged on stages 2 installed at equal angles from the center of a lower-part electrode 1 and they are etched simultaneously. In this apparatus, the lower-part electrode 1 is turned around its central axis and the stages 2 are rotated and revolved. For example, a lower-part electrode 1 is turned by using a motor 5.
A fixed gear 3 is mated with gears 4 for stage rotation use; stages 2 are turned when the lower-part electrode 1 is turned. By using such a planetary gear mechanism, wafers are rotated and revolved. Thereby, etching rate between individual wafers is made uniform and, in addition, etching rate at individual points inside a wafer can be made uniform.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio

日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-69119

®Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 每公開 平成3年(1991)3月25日

H 01 L 21/302

С 8122-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

60発明の名称 バツチ式ドライエツチング装置

> 20特 顧 平1-206213

29出 願 平1(1989)8月8日

個発 明 者 中尾

山口県厚狭郡楠町大字東万倉字神元192番地 - 3 山口日

本電気株式会社内

の出 願 人 山口日本電気株式会社

山口県厚狭郡楠町大字東万倉字神元192番地一3

個代 理 人 弁理士 内原

印 細 重

発明の名称

バッチ式ドライエッチング装置

特許請求の範囲

下部電極上にその中心から等角度に設置された ステージにウェハースを並べ、同時にエッチング を行なうバッチ式ドライエッチング装置におい て、前記下部電極を前記中心軸まわりに回転させ て前記ステージを自転及び公転させることを特徴 とするバッチ式ドライエッチング装置。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体製造装置のドライエッチング装 置に関し、特にバッチ式ドライエッチング装置に 関する。

〔従来の技術〕

従来、この種のドライエッチング装置には、第

3 図 (a). (b) の上面図及びその断面図に示 すように、平行平板電極の下部電極1上に、その 中心から等角度に複数のステージ2を設け、ウェ ハースを何枚か並べて同時にエッチングを行なう バッチ方式のものがある。

(発明が解決しようとする課題)

上述した従来のパッチ式ドライエッチング装置 では、半導体の高集積度化によるエッチングパタ ーンの微細化、及びウェハースの大口径化に伴 い、ウェハース間及びウェハース内のエッチング 速度の均一性が悪くなるという欠点がある。

上述した従来のバッチ式ドライエッチング装置 に対し、本発明は、下部電極を回転させ、さらに ウェハースを載せたステージを回転させることに より、ウェハース同及びウェハース内のエッチン グ速度の均一性を向上させるようにしたものであ

〔課題を解決するための手段〕

本発明のバッチ式ドライエッチング装置は、ウ ェハース間のエッチング速度の均一性を向上させ

特開平3-69119(2)

るための下部電極回転機構と、ウェハース内のエッチング速度の均一性を向上させるためのステージ回転機構とを有している。

〔実施例〕

次に、本発明について図面を参照して説明する。第1図は本発明の第1の実施例の縦断面図である。下部電極1がモーター5によって回転する。固定ギア3とステージ回転用ギア4がかみ合っており、下部電極1の回転に伴いステージ2が回転する。このプラネタリーギア機構により、ウェハースは自転及び公転を行なう。

第2図は本発明の第2の実施例の縦断面図である。下部電極1がモーター5によって回転する。 ステージ回転用ギア4が処理室外壁6の内側に設けられたインターナルギアとかみ有っており、下部電極1の回転に伴いステージ2が回転する。 〔発明の効果〕

以上説明したように本発明は、ウェハースの乗った下部電極をエッチング中に回転させることにより、各ウェハース間のエッチング速度を均一に

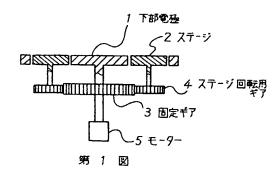
し、さらに、下部電極の回転と連動してステージ を回転させ、ウェハース自身も回転させることに より、ウェハース内の各点のエッチング速度も均 ーにできるという効果がある。

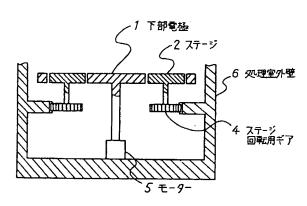
図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例の構成図、第2図は本発明の第2の実施例の構成図、第3図(a),(b)は従来のバッチ式ドライエッチング装置の上面図と断面図を示したものである。

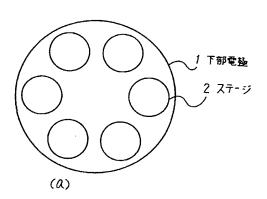
1 … 下部電極、2 … ステージ、3 … 固定ギア、4 … ステージ回転用ギア、5 … モーター、<u>6</u> … 処理室外壁。

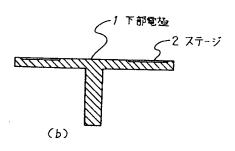
代理人 弁理士 内 原 智





第 2 図





第 3 図